

ТИРИСТОРЫ

T115-6,3, T115-10, T115-16

Общие сведения

Тиристоры T115 выпускают в корпусе с беспотенциальным основанием фланцевого исполнения. Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 500 Гц и применяются в различных преобразователях электроэнергии в бесконтактной коммутационной и регулирующей аппаратуре.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение и категория размещения У2 для эксплуатации в атмосфере типа I и II по ГОСТ 15150-69.

Тиристоры предназначены для эксплуатации во взрывобезопасных и химически неактивных средах, в условиях исключающих воздействие различных излучений (нейтронного, электронного, гамма-излучения).

Тиристоры допускают воздействие вибрационных нагрузок до 100 Гц с ускорением 50 м/с^2 и одиночных ударов длительностью импульса 50 мс и ускорением 40 м/с^2 . Группа M27 условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90.

Тиристоры по своим параметрам и характеристикам соответствуют ТУ У 32.1-30077685-005-2002.

Комплектность поставки и формулирование заказа

Тиристоры, по согласованию с предприятием-изготовителем, могут поставляться с охладителем и комплектом крепежных деталей.

К каждой партии тиристоров, транспортируемых в один адрес, прилагается этикетка.

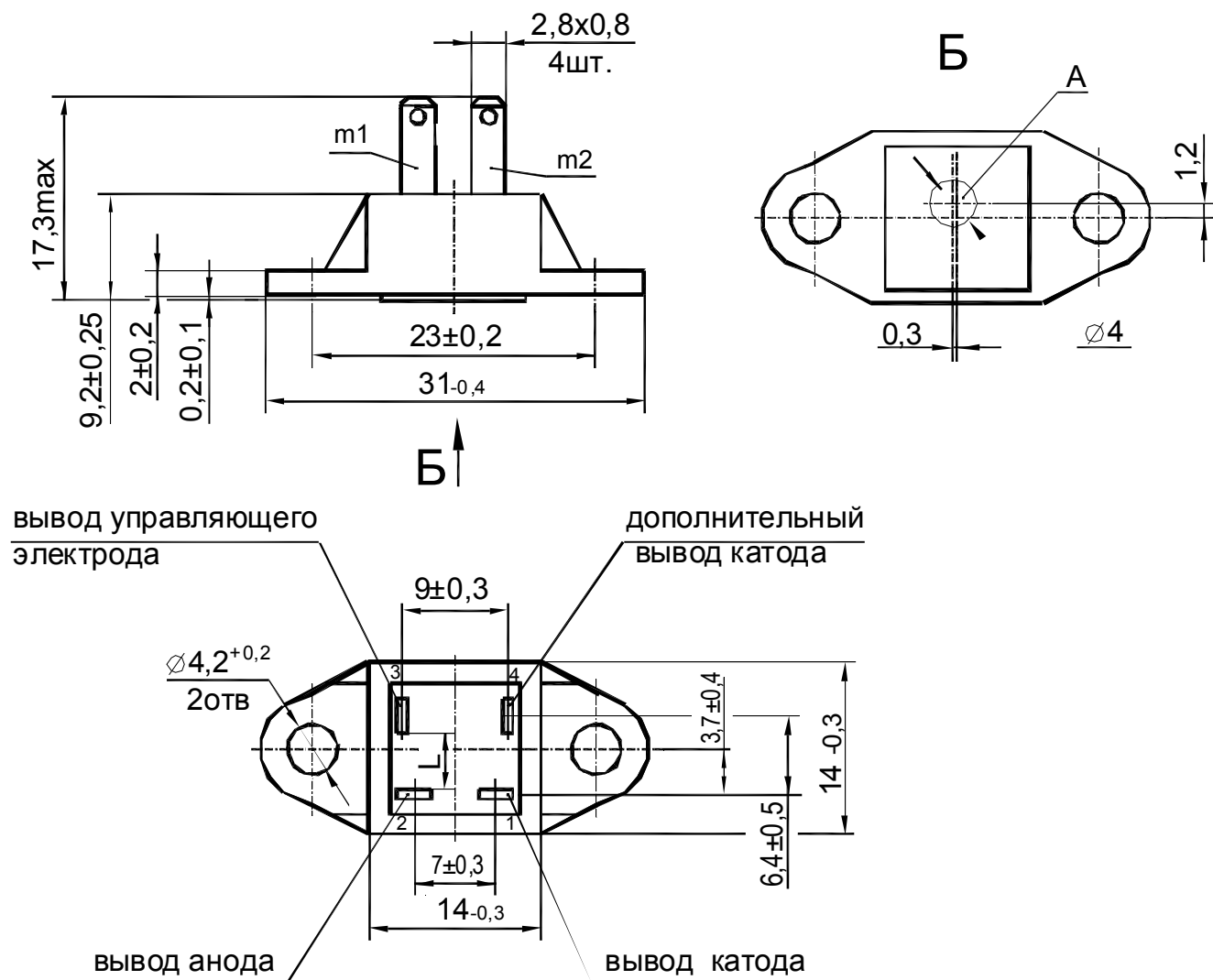
При заказе необходимо указать:

тип, класс, группу по критической скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, количество, номер технических условий.

Пример заказа 100 штук тиристоров типа T115-16 двенадцатого класса с критической скоростью нарастания напряжения в закрытом состоянии по шестой группе.

T115-16-12-6 ТУ У 32.1-30077685-005-2002 100 шт.

Габаритно-присоединительные размеры, масса тиристоров



- А** - область контроля температуры корпуса тиристора;
m1, m2 - контрольные точки измерения импульсного напряжения в открытом состоянии;
L - минимальное расстояние по воздуху между выводом анода и выводом управляющего электрода и длина пути для тока утечки между этими выводами 4,1 мм.

Масса не более 5 г

Растягивающая сила для выводов катода, анода, управляющих электродов $20_{\pm 2,0}$ Н.

Параметры закрытого состояния

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	T115-6.3 T115-10 T115-16	
U_{DSM} U_{RSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 2 4 5 6 8 9 10 11 12	 225 450 560 670 900 1000 1100 1200 1300	$T_{jm}=125^{\circ}\text{C}$. Импульс напряжения синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, управляющий вывод разомкнут.
U_{DRM} U_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение, В, для классов: 2 4 5 6 8 9 10 11 12	 200 400 500 600 800 900 1000 1100 1200	$T_{jm}=125^{\circ}\text{C}$. Импульсы напряжения синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц, управляющий вывод разомкнут.
U_{DWM} U_{RWM}	Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии и рабочее импульсное обратное напряжение, В	$0,8U_{DRM}$ $0,8U_{RRM}$	
U_D U_R	Постоянное напряжение в закрытом состоянии и постоянное обратное напряжение, В	$0,6U_{DRM}$ $0,6U_{RRM}$	$T_c=75^{\circ}\text{C}$
$(du_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс, не менее, для группы: 1 2 3 4 5 6	 20 50 100 200 320 500	$T_{jm}=125^{\circ}\text{C}$; $U_{DM}=0,67U_{DRM}$; $t_u \geq 200\text{мкс}$. Цепь управления разомкнута.
I_{DRM} I_{RRM}	Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, повторяющийся импульсный обратный ток, мА, не более	1,7 2,5	$T_{jm}=25^{\circ}\text{C}$ Цепь управления разомкнута. $T_{jm}=125^{\circ}\text{C}$ Цепь управления разомкнута.

Параметры открытого состояния

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	T115-6.3	T115-10	T115-16	
$I_{T(AV)M}$	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	6,3	10	16	$T_c = 75^\circ\text{C}$ Импульсы тока синусоидальные однополупериодные длительностью не более 10 мс частотой 50 Гц.
	Фактический максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, А	9	12	17	
I_{TRMSM}	Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии, А	10	16	25	
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии, А	99	143	220	$T_j = 25^\circ\text{C}$
		90	130	200	$T_{jm} = 125^\circ\text{C}$. Импульс тока синусоидальный однополупериодный одиночный длительностью не более 10 мс, $U_R = 0$, $I_G = I_{GT}$ при T_{jmin} .
U_{TM}	Импульсное напряжение в открытом состоянии, В, не более	1,8	1,75	1,7	$T_j = 25^\circ\text{C}$, $I_T = 3,14 I_{T(AV)M}$
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение в открытом состоянии, В, не более	1,15			$T_j = 25^\circ\text{C}$
		1,0			$T_{jm} = 125^\circ\text{C}$
r_T	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, мОм, не более	32,9	19,1	10,9	$T_j = 25^\circ\text{C}$
		40	24,0	14,0	$T_{jm} = 125^\circ\text{C}$
I_H	Ток удержания, мА, не более	70			$T_j = 25^\circ\text{C}$, $U_D = 12$ В, цепь управления разомкнута.
$I_{T(AV)}$	Средний ток в открытом состоянии на охладителе* при $T_a = 40^\circ\text{C}$, А	2,8	3,1	3,4	естественное охлаждение

* Допускается применять любой охладитель толщиной 0,5 мм с площадью поверхности не менее 16 см² с одной стороны, тепловое сопротивление должно быть не более 18 °C/Вт. Материал охладителя должен иметь теплопроводность не менее 210 Вт/(м·°C).

Параметры управления

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	T115-6.3, T115-10, T115-16	
U_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления, В, не более	2,5	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$
		3,5	$T_{j\min}=-40^{\circ}\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления, мА, не более	45	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$
		120	$T_{j\min}=-40^{\circ}\text{C}$, $U_D=12\text{ В}$
U_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления, В, не менее	0,3	$T_{jm}=125^{\circ}\text{C}$ $U_D=0,67U_{\text{DRM}}$

Параметры переключения

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	T115-6.3 T115-10 T115-16	
$(di_T/dt)_{\text{crit}}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, А/мкс	100	$f = 1\div 5\text{ Гц}$, $I_T=2I_{\text{TAVM}}$, $t_{iG}=50\text{ мкс}$, $I_G \geq I_G$ при $T_{j\min}$, $t_i=10\text{ с}$
t_q	Время выключения, мкс, не более	160	$T_{jm}=125^{\circ}\text{C}$, $t_{i\min}=300\text{ мкс}$ (на уровне 0,9 от амплитуды), $-(di_T/dt)=5\text{ А/мкс}$, $t_{u\min}=200\text{ мкс}$ (на уровне 0,9 от амплитуды), $du_D/dt=20\text{ В/мкс}$

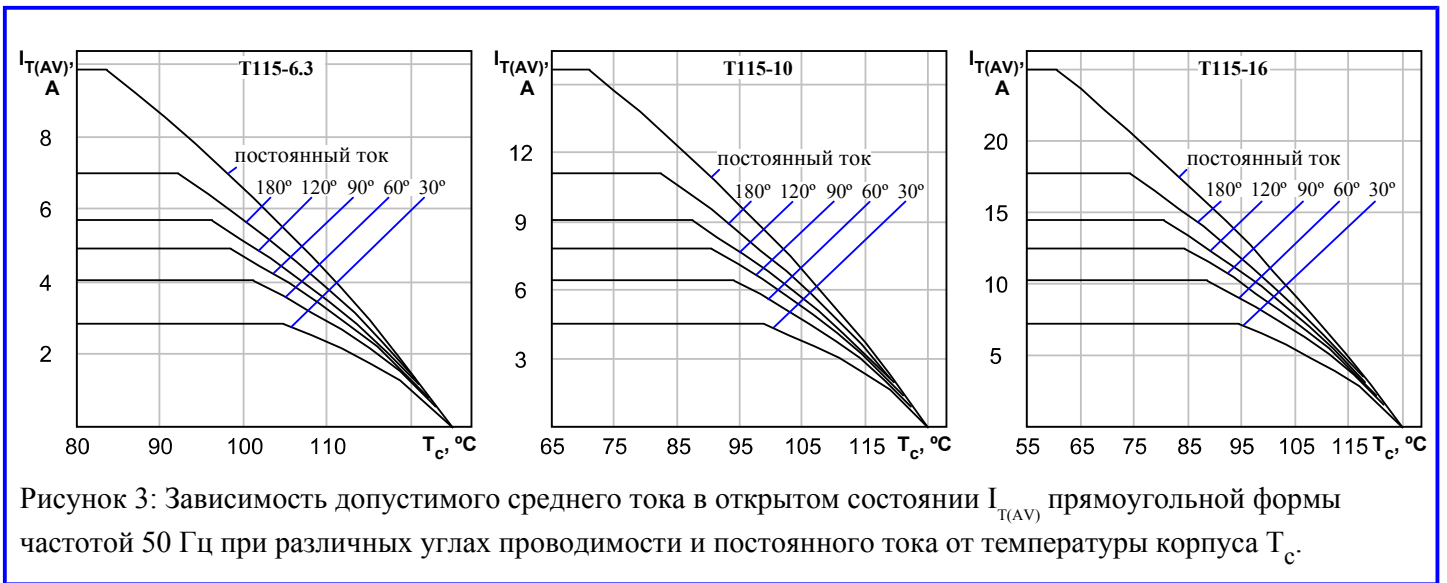
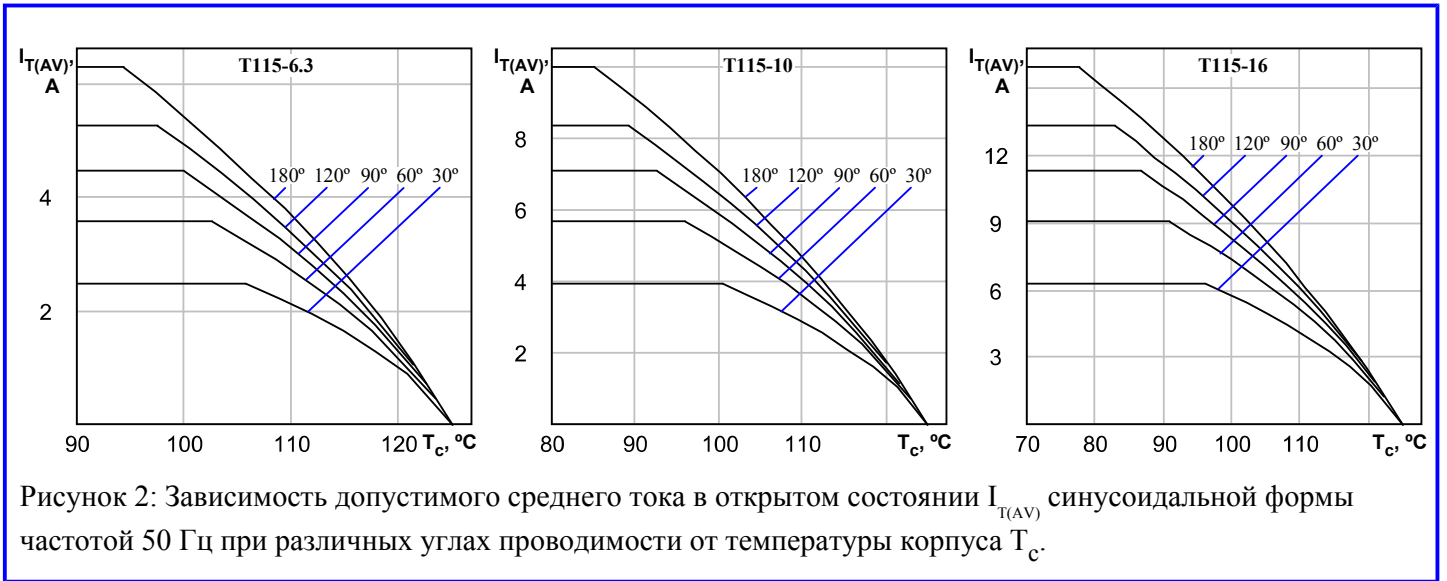
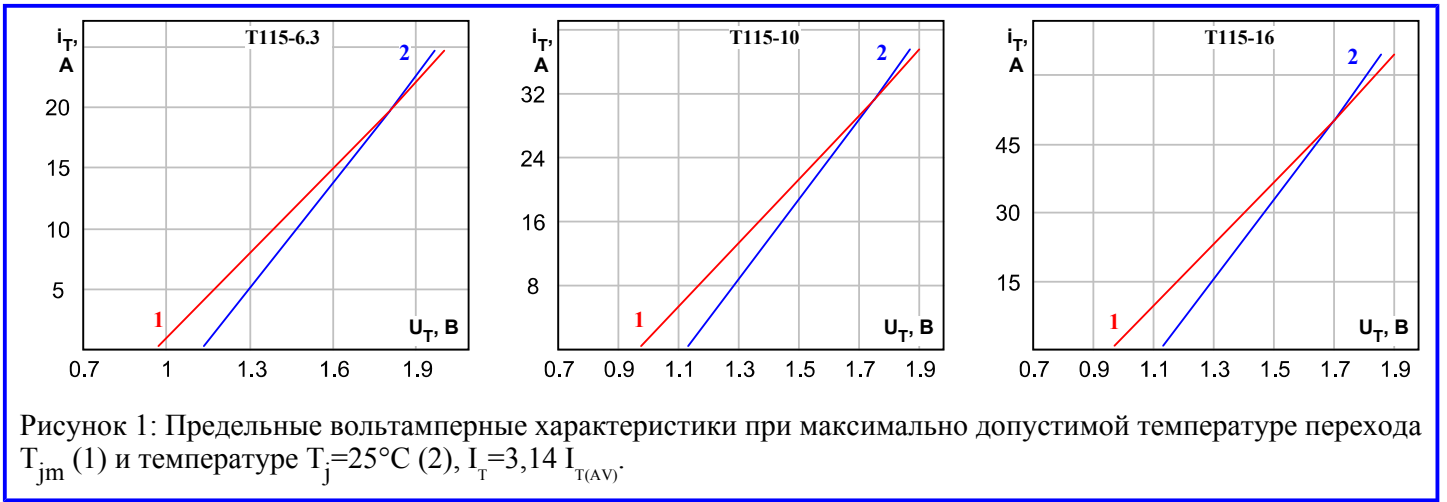
Тепловые параметры

Параметр		Значение параметра			Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	T115-6.3	T115-10	T115-16	
T_{jm}	Максимально допустимая температура перехода, °C	125			
T_{jmin}	Минимально допустимая температура перехода, °C	минус 40			
T_{stgm}	Максимально допустимая температура хранения, °C	50			
T_{stgmin}	Минимально допустимая температура хранения, °C	минус 40			
R_{thjc}	Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт, не более	3	2.5	1.9	Постоянный ток
R_{thch}	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, °C/Вт, не более	2.68			
R_{thja}	Тепловое сопротивление переход-среда с охладителем *, °C/Вт, не более	23,68	23,18	22,58	естественное охлаждение

* Допускается применять любой охладитель, соответствующий требованиям, приведённым в таблице с параметрами открытого состояния.

Параметры гальванической развязки

Параметр		Значение параметра	Условия установления норм на параметры
Буквенное обозначение	Наименование, единица измерения	T115-6.3 T115-10 T115-16	
U_{isol}	Электрическая прочность изоляции между беспотенциальным основанием прибора и его выводами, В, (действующее значение)	2000 (для 2-8 кл.) 2500 (для 9-16 кл.)	Нормальные климатические условия. Частота испытательного напряжения 50 Гц. Время выдержки под напряжением 1 мин.
R_{isol}	Сопротивление изоляции между беспотенциальным основанием прибора и его выводами, МОм, не менее	30	Нормальные климатические условия. $U_{isol}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.
		3	Повышенная влажность. $U_{isol}=1000$ В. Время приложения испытательного напряжения не менее 10 с.



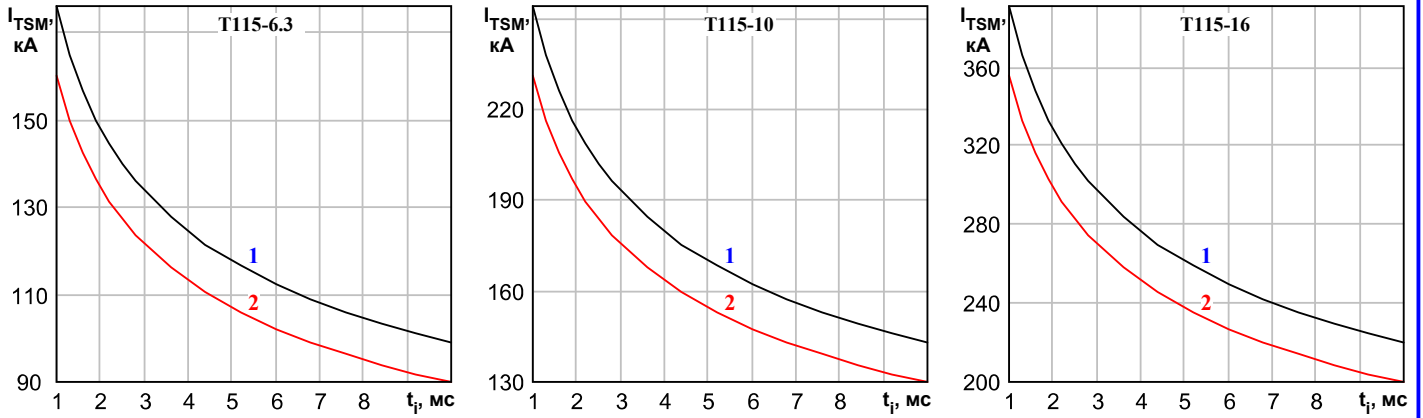


Рисунок 4: Зависимость допустимой амплитуды ударного тока в открытом состоянии I_{TSM} от длительности импульса тока t_i при исходной температуре структуры $T_j=25^\circ\text{C}$ (1) и максимально допустимой температуре перехода T_{jm} (2).

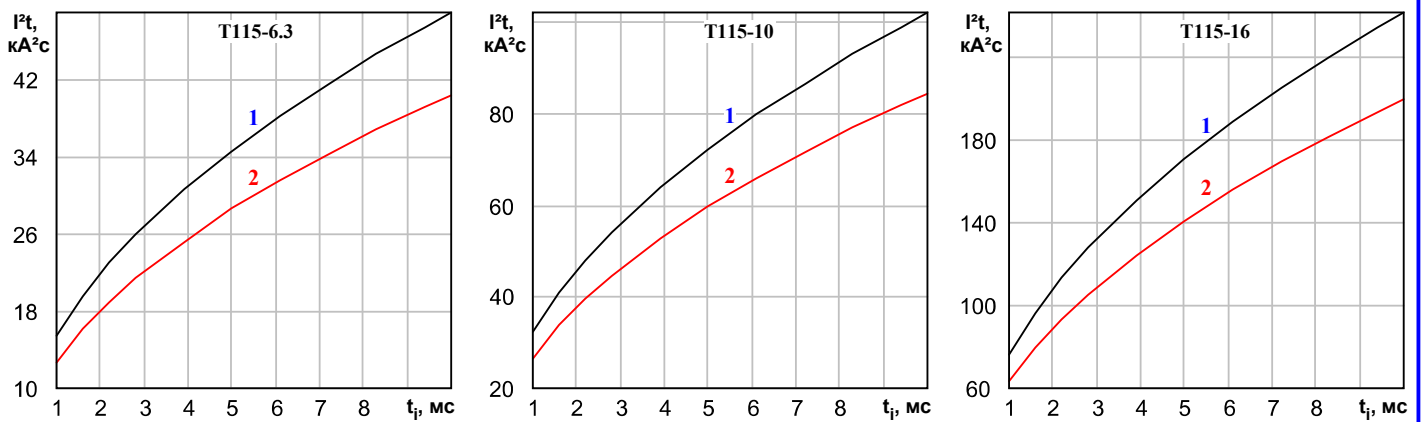


Рисунок 5: Зависимость защитного показателя I^2t от длительности импульса тока t_i при исходной температуре структуры $T_j=25^\circ\text{C}$ (1) и максимально допустимой температуре перехода T_{jm} (2).

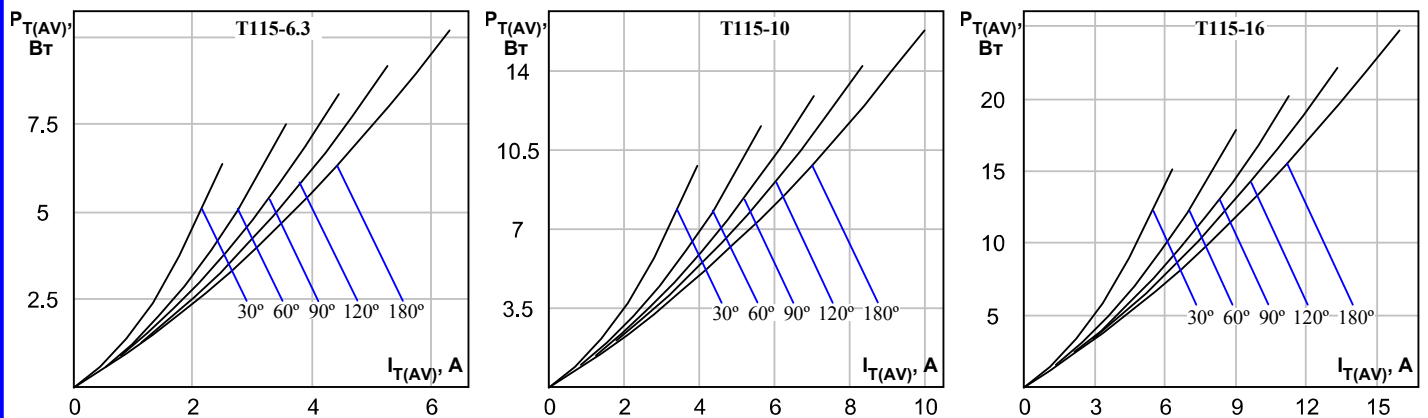


Рисунок 6: Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии $P_{T(AV)}$ от среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ синусоидальной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости.

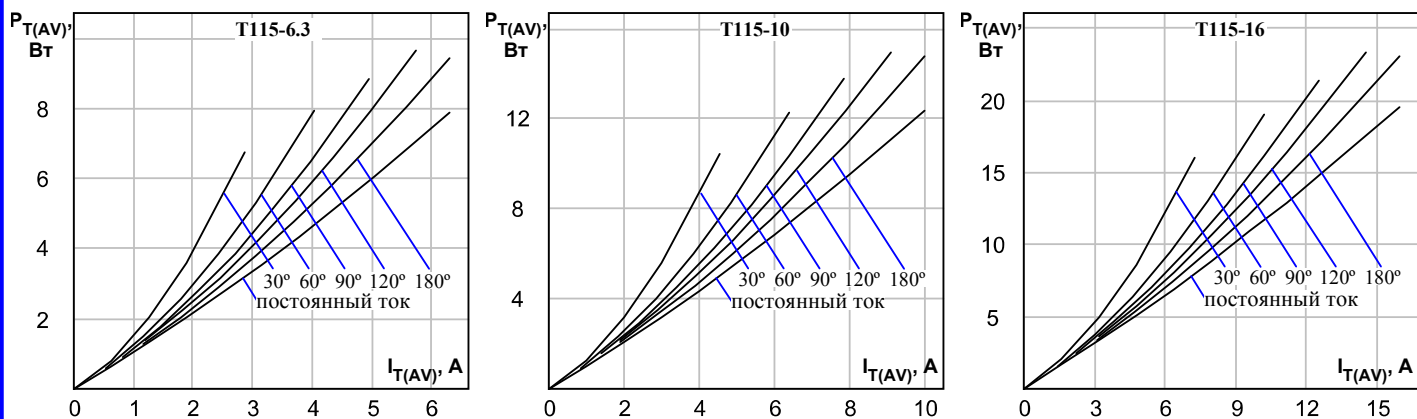


Рисунок 7: Зависимость средней рассеиваемой мощности в открытом состоянии $P_{T(AV)}$ от среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ прямоугольной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока.

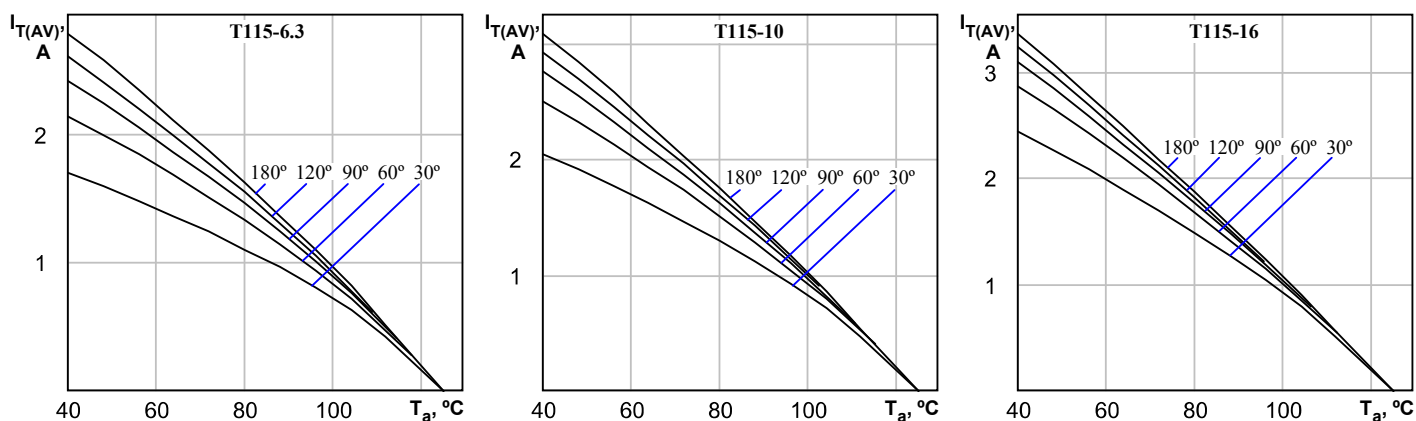


Рисунок 8: Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ синусоидальной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении на охладителе, соответствующем требованиям, упомянутым в таблице параметров в открытом состоянии.

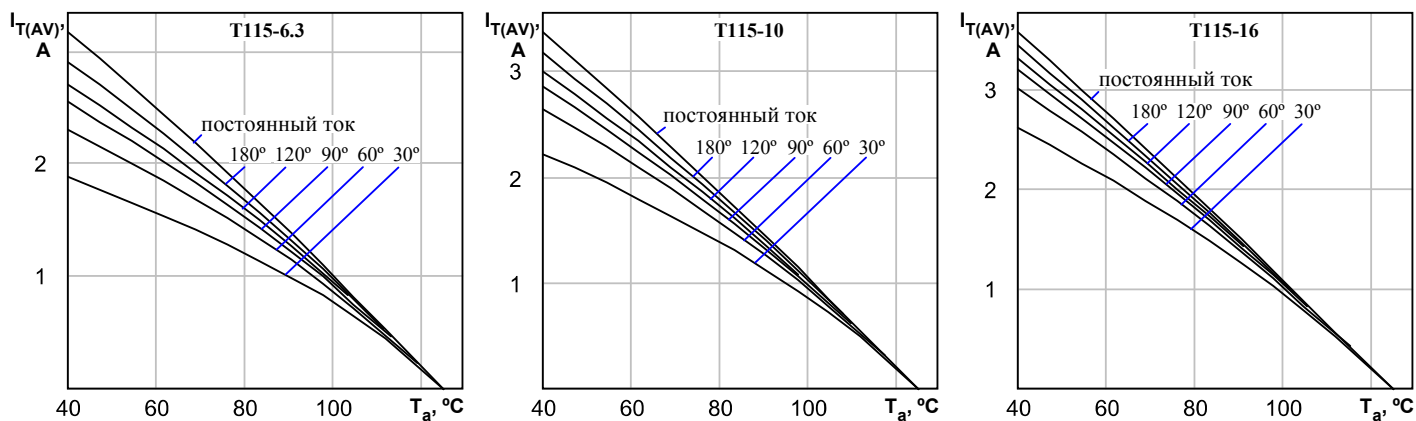


Рисунок 9: Зависимость допустимого среднего тока в открытом состоянии $I_{T(AV)}$ прямоугольной формы частотой 50 Гц при различных углах проводимости и постоянного тока от температуры окружающей среды T_a при естественном охлаждении на охладителе, соответствующем требованиям, упомянутым в таблице параметров в открытом состоянии.